

更改记录(V0.0-V1.0)

- 1 删除继电器自锁电路(U5,R6,R8,C22,C23,C24)
- 2 新增EN, IOO, IO15, VCC3.3,GND五个测试点
- 3 EN带RC延时 (R13=10K,C10=0.1UF)
- 4 调整IO控制,并做智能灯兼容设计:增加8PIN2.0MM排针J1
- 5 为了 优化射频性能,降低成本,L1,C4,C5换成0201封装

更改记录(V1.0-V2.0)

- 1 新增ESD器件D1
- 2 删除IO2,用IO5替换IO2的位置,新增IO16替换IO5的位置

